

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

30

PCT

NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT
D'UN CHANGEMENT(règle 92bis.1 et
instruction administrative 422 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

LEHU, Jean
c/o Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris
FRANCE

| | |
|---|---|
| Date d'expédition (jour/mois/année) 10 février 2005 (10.02.2005) | NOTIFICATION IMPORTANTE |
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire B 14211.3 PR | |
| Demande internationale no PCT/FR2003/050072 | Date du dépôt international (jour/mois/année) 02 octobre 2003 (02.10.2003) |

| | | |
|---|--|---|
| 1. Les renseignements suivants étaient enregistrés en ce qui concerne: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> le déposant | <input checked="" type="checkbox"/> l'inventeur | <input type="checkbox"/> le mandataire <input type="checkbox"/> le représentant commun |
| Nom et adresse | Nationalité (nom de l'Etat) | Domicile (nom de l'Etat) |
| | no de téléphone | |
| | no de télécopieur | |
| | no de téléimprimeur | |
| 2. Le Bureau international notifie au déposant que le changement indiqué ci-après a été enregistré en ce qui concerne: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> la personne | <input type="checkbox"/> le nom | <input type="checkbox"/> l'adresse <input type="checkbox"/> la nationalité <input type="checkbox"/> le domicile |
| Nom et adresse BOUCHIAT, Vincent 11, Lotissement Castel Novel F-38330 Biviers FRANCE EPO - CG 1 25.02.2005 (52) | Nationalité (nom de l'Etat) FR | Domicile (nom de l'Etat) FR |
| | no de téléphone | |
| | no de télécopieur | |
| | no de téléimprimeur | |
| 3. Observations complémentaires, le cas échéant: La personne mentionnée au cadre 2 doit être ajoutée à la demande internationale comme déposant pour les Etats Unis d'Amérique et inventeur pur tous les Etats désignés. | | |
| 4. Une copie de cette notification a été envoyée: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> à l'office récepteur | <input type="checkbox"/> aux offices désignés concernés | |
| <input type="checkbox"/> à l'administration chargée de la recherche internationale | <input checked="" type="checkbox"/> aux offices élus concernés | |
| <input type="checkbox"/> à l'administration chargée de l'examen préliminaire international | <input type="checkbox"/> autre destinataire: | |

| | |
|--|--|
| Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Genève 20, Suisse no de télécopieur: (41-22) 338.89.95 | Fonctionnaire autorisé: R.BEN GHACHEM (Fax 338-8995) no de téléphone: (41-22) 338 8762 |
|--|--|

B 14211.3/PR

8

English translation of the amended sheets of
International Preliminary Examination Report

CLAIMS

1. Process for manufacturing nanowire structures,
characterised in that it comprises:

- 5 - manufacture of a thin semiconductor film (1)
 extending between a first terminal (4) and a
 second terminal (5), and
- 10 - passage of a current between the first and the
 second terminals so as to form at least one
 continuous overthickness (R1, R2, R3) in the thin
 semiconductor film by migration of a fraction of
 the semiconductor material under the action of the
 current, the continuous overthickness being formed
 along the direction of the current that passes
- 15 through the film, and
- etching of the thin film to form at least one
 nanowire (F1, F2, F3) from the continuous
 overthickness(es) (R1, R2, R3).

20 2. Process according to claim 1, characterised in
 that the thin semiconductor film is obtained by
 lithography and/or etching of a thin semiconductor layer
 formed on an insulating layer.

25 3. Process according to any one of the above claims,
 characterised in that the thin semiconductor film is a
 thin film of Si, SiGe or SiGeC.

English translation of the amended sheets of
International Preliminary Examination Report

4. Process according to any one of the above claims,
characterised in that the semiconductor is doped.

5. Process according to any one of the above claims,
5 characterised in that the semiconductor is
monocrystalline.

6. Process for etching a layer using a hard mask,
characterised in that the hard mask used is a nanowire
10 structure obtained by a manufacturing process according
to any one of claims 1 to 5.